智慧財產及商業法院行政判決

111年度行專訴字第53號
民國112年3月9日辯論終結

原　　告　吳建一
訴訟代理人　吳宜恬律師
被　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　洪淑敏
訴訟代理人　徐七冠
參　加　人　台灣陶瓷工業同業公會
代　表　人　林榮德
訴訟代理人　蔣文正律師
複 代理 人　蘇英偉律師
　　何娜瑩律師
訴代輔佐人　林易

上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國111年7月15日經訴字第11106305240號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：

主　文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、被告之代表人原為洪淑敏，嗣於訴訟程序中變更為廖承威，業據其具狀聲明承受訴訟在卷，經核並無不合，爰准許之。

二、事實概要：緣原告前於民國106年4月21日以「具去除懸浮微粒之拋光石英磚組成」向被告機關申請新型專利，申請專利範圍共5項，經被告編為第106205589號形式審查後，准予專利，並發給新型第M548192號專利證書(下稱系爭專利)。嗣參加人以系爭專利有違核准時專利法第120條準用第22條第1項第2款、第3款規定，對之提起舉發，經被告以110年8月30日(110)智專三㈠06020字第11020845900號函通知參加人確認舉發法條、理由與證據，經參加人限縮舉發證據為證據

1、5、9、11，並變更主張系爭專利違反核准時專利法第120條準用第22條第2項規定，經被告審查後，以111年3月9日(111)智專三㈠06020字第11120239860號專利舉發審定書為請求項1至5舉發成立，應予撤銷之處分，原告不服，提起訴願，復遭經濟部為訴願駁回之決定，原告仍未甘服，遂依法提起本件行政訴訟。本院因認本件判決結果，倘認為訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益恐將受有損害，爰依職權裁定命參加人獨立參加本件訴訟。

三、原告主張：

㈠系爭專利請求項1之主要結構係「去除懸浮微粒特質的化學藥劑層」、「透光遮覆層」及「基礎部件」所結合之拋光石英磚，證據2係奈米科技及材料之報導，主要係描述奈米光觸媒之特性，與系爭專利「具去除懸浮微粒特質的化學藥劑層」結構無關；證據3則係介紹將奈米材料應用於拋光磚，亦與系爭專利前揭結構無關，與系爭專利可達成之「驅使應用在建築物相應周遭環境存有的懸浮微粒朝地面沉降」功能完全不同；而證據5係工業技術研究院函，為奈米光觸媒抗污陶瓷面磚驗證規範，係揭示一種表面含有奈米光觸媒之陶瓷面磚，與系爭專利前揭結構及功能不同；另證據6為奈米表面處理抗污衛生陶瓷器驗證規範，同樣係揭示藉由奈米處理以達到疏水防污之特性，使髒物不易附著，與系爭專利前揭結構無關，亦與系爭專利前揭功能不同；至證據7為「奈米金屬複合物抗菌室內牆面用陶瓷面磚驗證規範」，亦係揭示藉由奈米處理使陶瓷面磚具備抗菌功能，與系爭專利前揭結構無關。而證據9係光觸媒材料性能測定法相關報導，為對光觸媒之測試及制定，與系爭專利主要構件「去除懸浮微粒特質的化學藥劑層」、「透光遮覆層」結構無關。證據5與證據9之組合僅在揭露「奈米光觸媒之陶瓷面磚」親水機制，使殘留之污垢容易被雨水沖下，與系爭專利利用去除懸浮微粒特質之化學藥劑層，驅使應用在建築物相應周遭環境存有的懸浮微粒朝地面沉降結構技法不同。證據11為奈米表

面處理抗污陶瓷面磚驗證規範，雖提及奈米結構可抗污特性，惟未揭露系爭專利前揭結構及功能，是證據5、9之組合及證據9、11之組合無法證明系爭專利請求項1不具進步性。又證據4亦為工業技術研究院函，證據4、證據5之功能亦為藉由奈米光觸媒表面親水機制使污垢容易被水沖下，與系爭專利不同，是證據5、9之組合與證據9、11之組合，均無法證明系爭專利請求項2不具進步性。系爭專利請求項3為請求項1之附屬項，上開證據之組合既無法證明請求項1不具進步性，自亦無法證明請求項3不具進步性。

㈡系爭專利請求項4之主要結構係一種具「去除懸浮微粒特質的化學藥劑層」、「透光遮覆層」及「基礎部件」，以及將該等構件藉一預設溫度進行燒製所結合之拋光石英磚，上開技術特徵並未見於證據2、3、4、5、6、7，而證據8為「奈米超親水光觸媒水溶膠建議施工程序」，主要係揭示結晶化玻璃之奈米光觸媒之施工，證據8與證據9皆係對光觸媒之描述，與系爭專利請求項4之「去除懸浮微粒特質的化學藥劑層」、「透光遮覆層」無關。證據5、證據9之組合，以及證據9與證據11之組合雖有揭露可選用不同形狀、大小、顏色之特徵，惟並未揭露系爭專利請求項4之「去除懸浮微粒特質的化學藥劑層」、「透光遮覆層」及「基礎部件」等結構，系爭專利藉由「化學藥劑層」去除懸浮微粒之特徵，明顯優於證據5、證據9之組合，以及證據9與證據11之組合，是系爭專利請求項4自具有進步性。系爭專利請求項5係依附於請求項4之附屬項，進一步界定該拋光石英磚之化學藥劑層在預設層面結合之透光遮覆層係以釉料層為其一選擇，證據5、證據9之組合，以及證據9與證據11之組合既無法證明請求項4不具進步性，自亦無法證明請求項5不具進步性。至證據10乃台灣奈米發展報導、證據11乃奈米表面處理抗污陶瓷面磚驗證規範，證據12為奈米標章使用證書，均係用以佐證奈米之應用，並未涉及系爭專利之技術，自不足以證明系爭專利不具進步性。系爭專利將化學藥劑層直接結合於拋光

石英磚之基礎部件，驅使相應環境所存有之懸浮微粒朝地面沉降，過程中不需要如同光觸媒需藉由太陽光或照明燈之紫外線作為觸媒，系爭專利並不含光觸媒成分，兩者之構成要件及結構技法完全不同。系爭專利先前申請技術報告時獲得代碼6之比對結果，足見系爭專利於申請前未見於任何公開之刊物或先前技術，被告竟於本件處分認定系爭專利不具進步性，顯自相矛盾等語。聲明求為判決：1.訴願決定及原處分均撤銷。2.訴訟費用由被告負擔。

四、被告則以：原告雖主張證據2、3、4、5、6、7存在差異，惟參加人僅主張證據5與證據9之組合，以及證據9與證據11之組合足以證明系爭專利請求項1至5不具進步性，至證據2、3、4、6、7均不在原處分爭點內，先予敘明。系爭專利僅於請求項中界定化學藥劑層，此用語乃屬上位概念，未界定該化學藥劑層之成分或內容，奈米光觸媒亦屬一種化學藥劑，自包含在內。系爭專利之主要結構係去除懸浮微粒特質的「化學藥劑層」及「基礎部件」，而於化學藥劑層上係「可」結合「透光遮覆層」，證據5已揭示傳統習知陶瓷面磚於基礎部件(無機陶瓷)結合外表面之透光遮覆層(釉料)之結構，並揭示系爭專利請求項1面磚之基礎部件表面上結合有化學藥劑層(如光觸媒材料)，證據9亦揭示傳統磁磚結構結合化學藥劑層(光觸媒材料)後具有抗菌、自我潔淨等結構及功能，因此證據5、9已揭露系爭專利之主要結構及技術特徵。系爭專利既未說明其化學藥劑層之成分內容，亦未說明其化學藥劑層不含奈米光觸媒，其所稱產生之「具去除懸浮微粒特質」功效亦無法證明其化學藥劑層成分是否不具有奈米光觸媒，自不能排除證據5、9所揭露之技術特徵。又懸浮微粒之移除主要係藉由沉降作用，包括濕沉降與乾沉降兩大類，前者指微粒隨同雨、雪、霧、雹等降水型態落到地面，後者指懸浮微粒藉由碰撞而增大質量，受重力影響而自然落下，另乾沉降亦可藉由綠建材移除懸浮微粒。由是可知，利用磁磚或建材結合化學藥劑如二氧化鈦以消除懸浮微粒，乃

系爭專利申請前之習知技術，證據5、9之組合及證據9、11之組合均已揭露系爭專利之技術特徵，故系爭專利請求項1至5不具進步性等語為辯。聲明：駁回原告之訴。

五、參加人則以:證據5前言已揭示「奈米光觸媒陶瓷面磚照光後具有強氧化能力，可分解附著於陶瓷磚表面之有機汙染物…」等語，系爭專利說明書、實施方式及圖式未界定其化學藥劑層之具體實施選擇或反應機制，解釋上自不能排除奈米光觸媒。而奈米光觸媒為一種化學品，具有去除懸浮微粒特質，解釋上系爭專利請求項1之「具去除懸浮微粒特質的化學藥劑層」自包含奈米光觸媒。證據5已揭露一種奈米光觸媒抗污陶瓷面磚驗證規範，並揭示陶瓷面磚表面具有平均粒徑100nm以下之奈米光觸媒結構，而陶瓷面磚即為可供設置化學藥劑層之基礎部件。又證據5前言已揭示傳統磁磚多為釉料與無機陶瓷之混合物，可知在陶瓷面磚上設置釉料層為通常知識，系爭專利請求項1所界定之「透光遮覆層」已為證據5揭示。而證據9已揭示光觸媒材料具有淨化空氣之作用，且能夠應用於瓷磚等建材，是證據5、9之組合可證明系爭專利請求項1不具進步性。另系爭專利請求項2有關在基礎部件朝內一側結合化學藥劑層之特徵，僅係面向選擇，乃拋光石英磚業者可輕易思及者，而證據5已揭示系爭專利請求項3陶瓷面磚上設置釉料層之技術特徵，是證據5、9之組合可以證明系爭專利請求項2、3不具進步性。又證據5已記載陶瓷面磚係指一般建築用之陶瓷材料面磚，不論其形狀、外觀與結構，可知不論陶瓷面磚之形狀、外觀與結構為何，均可在其上設置層體，已揭露系爭專利請求項4之技術特徵，是證據5、9之組合可以證明系爭專利請求項4不具進步性。原告於申復時曾稱化學藥劑層係利用奈米礦石與溶劑溶解後所做的具負離子、紅外線之化學藥劑層，可知系爭專利之化學藥劑層涉及奈米相關之技術，原告縱否認化學藥劑層與奈米技術相關，惟其亦未說明化學藥劑層之具體內容，所述自非可採。證據11已揭露將奈米結構層體設置於建材之陶瓷面

磚上，加以在陶瓷面磚上設置釉料層乃系爭專利申請時之通常知識，足見系爭專利請求項1「在欲選擇條件的基礎部件表面是允許結合至少一層或以上的具去除懸浮微粒特質的化學藥劑層」以及「透光遮覆層」已為證據11所揭露，是證據9及證據11之組合可以證明系爭專利請求項1不具進步性。至系爭專利請求項2、3所揭示在基礎部件朝內一側結合化學藥劑層之技術特徵僅係面向的選擇，系爭專利請求項4所揭露依據牆面大小、形狀或位置不同而對陶瓷進行切割以配合實際需求，以及請求項5關於在陶瓷面磚上設置釉料層等，均屬通常知識，證據9、11之組合亦足以證明系爭專利請求項2、3、4、5不具進步性等語置辯。聲明：駁回原告之訴。

六、兩造之爭點：

㈠證據5、9之組合，可否證明系爭專利請求項1至5不具進步性？

㈡證據9、11之組合，可否證明系爭專利請求項1至5不具進步性？

七、得心證之理由：

㈠按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，固得依專利法第21條及第22條第1項前段之規定申請取得發明專利。惟發明如為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，不得取得發明專利，復為同法第22條第2項所明定。系爭專利之申請日為106年4月21日，核准審定日為106年7月3日，是以系爭專利是否有應撤銷之事由，自應以核准時即106年1月18日修正公布、106年5月1日施行之專利法為斷。

㈡系爭專利請求項共5項，其中請求項1、4為獨立項，其餘為附屬項，各請求項內容如附表所示。本件參加人雖提出證據2至證據12主張系爭專利不具進步性，惟參加人前於110年9月29日回應被告110年8月30日(110)智專三㈠06020字第11020845900號函之舉發陳述意見書中將舉發證據限縮為證據1(系爭專利)、5、9及11，並主張證據5、9之組合、證據9、1

1之組合足以證明系爭專利不具進步性等語，是本件有關系爭專利是否不具進步性之爭議，僅依前揭證據組合以為判斷，合先敘明。經查，證據5為100年1月9日之奈米標章產品驗證制度(奈米光觸媒抗污陶瓷面磚驗證規範，文件編號：TN-004)，其公開日早於系爭專利申請日(106年4月21日)，為適格之先前技術資料。證據5揭示奈米光觸媒陶瓷面磚照光後具有強氧化能力，可分解附著在瓷磚表面之有機污染物，下雨時因光觸媒瓷磚表面的超親水機制，殘餘的污垢很容易被雨水沖下，因此可達到淨化建材外觀之功效，使得瓷磚表面具有分解有機物質與自潔之功能，有助於維持建築物外觀之潔淨，提升生活品質(參證據5前言)。另證據9為100年11月23日之「標檢局制定『光觸媒材料性能測定法』國家標準提升產業技術及保障消費者權益」新聞稿，其公開日早於系爭專利申請日，亦為適格之先前技術。查證據9記載光觸媒為運用半導體材料(如二氧化鈦)特性，利用光照射能量激發材料中之電子，使產生氧化還原反應，具有分解、去除空氣及水中污染物及除臭、抗菌、自我潔淨等諸多性能，因此相關應用產品如建材(玻璃及瓷磚)、紡織品、空氣濾清機等亦陸續開發上市。至證據11則係101年8月17日之奈米標章產品驗證制度(奈米表面處理抗污陶瓷面磚驗證規範，文件編號：TN-041)，其公開日亦早於系爭專利申請日，為適格之先前技術。查證據11揭示奈米表面處理抗污原理包括親水型與疏水型二種，親水型之原理是藉由磁磚表面親水性之奈米結構與空氣中之水分形成薄膜水層，能夠防止污垢附著在面磚表面，疏水型之原理如同蓮花效應，藉由磁磚表面存在疏水性之奈米結構，使表面可以有自潔功效以防止污垢附著在面磚表面，有助於維持建築物外觀之潔淨，提升生活品質(參證據11前言)。

㈢證據5與證據9之組合足以證明系爭專利請求項1至5不具進步性：

1.有關系爭專利請求項1所揭露之技術特徵，詳如附表所示。經查，證據5第1頁第3.2點揭示「陶瓷面磚：係指一般建築用之陶瓷材質面磚」及前言揭示「傳統瓷磚多為釉料與無機陶瓷之混合物，其基本之功能僅限於美化或保護建材…。奈米光觸媒陶瓷面磚照光後具有強氧化能力，…因此可達到淨化建材外觀之功效。」等語，可知證據5之建築用建材、奈米光觸媒陶瓷面磚相當於系爭專利之建築物、拋光石英磚；且證據5係應用在建築用之奈米光觸媒陶瓷面磚，相當於系爭專利請求項1「是對應用在建築物內、外層面預設區域結合的拋光石英磚是包括：」技術特徵。另證據5第1頁之1.適用範圍揭示「本規範適用於表面含有奈米光觸媒之陶瓷面磚，且具有抗污功能者」及3.用語釋義揭示「3.1奈米光觸媒陶瓷面磚：係指陶瓷面磚表面含有平均粒徑100nm以下之奈米光觸媒材料，或表層材料具有平均粒徑100nm以下之奈米光觸媒結構者。3.2陶瓷面磚：係指一般建築用之陶瓷材質面磚」等語，可知證據5之陶瓷面磚、奈米光觸媒材料相當於系爭專利之基礎部件、化學藥劑層。又證據5之陶瓷面磚表面結合具有抗污功能之奈米光觸媒材料，相當於系爭專利請求項1之「在預選擇條件的基礎部件表面是允許結合至少一層或以上的具去除懸浮微粒特質的化學藥劑層，及」技術特徵。另證據5前言揭示「奈米光觸媒陶瓷面磚照光後具有強氧化能力，可分解附著在瓷磚表面之有機污染物，下雨時因光觸媒瓷磚表面的超親水機制，殘餘的污垢很容易被雨水沖下，因此可達到淨化建材外觀之功效，使得瓷磚表面具有分解有機物質與自潔的功能性；有助於維持建築物外觀之潔淨」等語，可知證據5所揭示之前揭技術手段及所取得之功效，相當於系爭專利之拋光石英磚在整體外層面保持預設定顏色(即不致被污垢遮蔽之功效)；且證據5之可分解附著在瓷磚表面之有機污染物，下雨時因光觸媒瓷磚表面的超親水機制，殘餘的污垢很容易被雨水沖下，相當並已揭露系爭專利請求項1之「使這種拋光石英磚在整體外層面保持預設

定顏色，一併能驅使應用在建築物相應周遭環境存有的懸浮微粒朝地面沉降，藉此消除空氣中難以去除的有害微粒應用。」技術特徵。

2. 證據9為「標檢局制定『光觸媒材料性能測定法』國家標準提升產業技術及保障消費者權益」新聞稿，該新聞稿記載「光觸媒為運用半導體材料(如二氧化鈦)特性，……具有如空氣及水中污染物之分解去除、除臭、抗菌、自我潔淨等諸多性能，因此相關應用產品如建材(玻璃及瓷磚)」等語，其中證據9所揭示之傳統瓷磚、光觸媒相當於系爭專利請求項1之基礎部件、化學藥劑層；且依據證據9前揭記載，可知傳統瓷磚結合具有分解去除、除臭、抗菌及自我潔淨功能之光觸媒，即相當於系爭專利請求項1「在預選擇條件的基礎部件表面是允許結合至少一層或以上的具去除懸浮微粒特質的化學藥劑層，及」技術特徵，並已揭露系爭專利請求項1之「使這種拋光石英磚在整體外層面保持預設定顏色，一併能驅使應用在建築物相應周遭環境存有的懸浮微粒朝地面沉降，藉此消除空氣中難以去除的有害微粒應用。」技術特徵。綜觀前述，證據5、9雖未揭露系爭專利請求項1「在前述的化學藥劑層預設層面是可結合至少一層或以上的透光遮覆層，在藉一預設外在力使前述結合化學藥劑層及透光遮覆層的基礎部件構成一拋光石英磚；」技術特徵，惟證據5前言已揭示「傳統瓷磚多為釉料與無機陶瓷之混合物」，且瓷磚表面上結合釉料為習知技術，此已相當於系爭專利之透光遮覆層。因此所屬技術領域具通常知識者於奈米光觸媒材料上結合釉料，再藉一預設外在力(例如燒製)使前述結合奈米光觸媒材料及釉料的陶瓷面磚形成一奈米光觸媒陶瓷面磚，即相當於系爭專利請求項1「在前述的化學藥劑層預設層面是可結合至少一層或以上的透光遮覆層，在藉一預設外在力使前述結合化學藥劑層及透光遮覆層的基礎部件構成一拋光石英磚；」之技術特徵，且證據5前言亦已揭示其可使得瓷磚表面具有自潔之功能，有助於維持建築物外觀之潔淨，顯

亦已揭示其所使用之技術手段能達成系爭專利之功效。而證據5、9均為磁磚相關技術領域，兩者之瓷磚表面均具有自我潔淨作用之共通功能，所屬技術領域具通常知識者自有動機依據證據5、9所揭示之技術內容，在瓷磚表面上結合使用釉料之習知技術，達成系爭專利請求項1所欲達成之功效。是所屬技術領域具通常知識者可依證據5、9之教示輕易完成系爭專利請求項1之技術內容，證據5、9之組合可證明系爭專利請求項1不具進步性。

3. 系爭專利並未界定請求項1化學藥劑層之特定組成為何，僅界定化學藥劑層具特定功能，亦未進一步限定「化學藥劑層不含奈米光觸媒」態樣，故解釋上不論有無奈米光觸媒均屬系爭專利請求項1所界定之範圍。其次，系爭專利請求項1並未進一步限定其係「不藉由『光能轉換成化學作用』，而利用大自然多孔質礦物之吸附、分解等離子還原原理達到環境淨化、抗菌效用之功能」態樣，是解釋上不論是否藉由「光能轉換成化學作用」而使懸浮微粒朝地面沉降，均屬系爭專利請求項1所界定之範圍。原告復稱系爭專利技術報告為代碼6，足見系爭專利具新穎性及進步性云云，惟查，技術報告僅係作為新型專利是否合於專利實體要件之參考，其比對結果並無任何拘束力，對於該新型專利之效力亦無任何影響，縱被告認定結果與該新型技術報告之結論不同，亦無法據此認被告嗣後撤銷原核准專利之處分與該新型技術報告矛盾，故原告所稱不可採。

4. 系爭專利請求項2為請求項1之附屬項，除具有請求項1之技術特徵外，並進一步界定如附表所示附屬技術特徵，二請求項之主要差異在於請求項2揭示「拋光石英磚亦可選擇在基礎部件的『朝內一側』…及在前述『朝內』的化學藥劑層」、「…使基礎部件『靠內一側』構成的拋光石英磚」等技術特徵，即以基礎部件「朝內一側」結合化學藥劑層、化學藥劑層「朝內」結合透光遮覆層所構成之拋光石英磚。然化學藥劑層設置於基礎部件的「表面」或「朝內一側」及透

光遮覆層設置於化學藥劑層的「表面」或「朝內一側」，乃所屬技術領域具通常知識者能輕易思及之位置簡單變更，並無困難。而證據5、9之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性，已如前述，是證據5、9之組合亦足以證明系爭專利請求項2不具進步性。

5. 系爭專利請求項3為請求項1之附屬項，除請求項1所揭示之技術特徵外，請求項3進一步界定「其中該拋光石英磚包括的化學藥劑層在預設層面結合的透光遮覆層，是以釉料層作為其一選擇」之技術特徵。經查，證據5於前言已揭示「傳統瓷磚多為釉料與無機陶瓷之混合物，」等語，可知在瓷磚表面上結合釉料乃習知技術，此部分即相當於系爭專利請求項3之透光遮覆層，所屬技術領域具通常知識者於奈米光觸媒材料上結合釉料之技術手段，已揭露系爭專利請求項3前揭技術特徵。而證據5、9之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性，業經說明如上，是證據5、9之組合亦足以證明系爭專利請求項3不具進步性。

6. 系爭專利請求項4為獨立項，有關其所揭露之技術特徵如附表所示，茲不復贅。而依本判決理由㈢1.段所述，證據5已揭示傳統陶瓷面磚於基礎部件(無機陶瓷)之外表面結合透光遮覆層(釉料)及表面含有平均粒徑100nm以下奈米光觸媒之陶瓷面磚結構，而在陶瓷面磚表面上釉乃所屬技術領域之通常知識，是證據5業已揭示系爭專利請求項4之「…基礎部件的作用表面是允許結合至少一層或以上的具去除懸浮微粒特質的化學藥劑層」技術特徵。另證據5前言揭示奈米光觸媒陶瓷面磚經照光後具有強氧化能力，其超親水機制更能使其表面污垢易於排除，具有淨化建材外觀功效，佐以證據9揭示在傳統磁磚結構結合化學藥劑層(光觸媒材料)後具有抗菌、自我潔淨等功能，可知證據5、9與系爭專利請求項4所揭示之結構均具有自我潔淨、抗菌及去除有害微粒之功效。至於陶瓷面磚之尺寸可視實際情況加以調整，乃所屬技術領域或者該領域業者向來之操作方式，並不具無法預期之功

效。因此所屬技術領域具通常知識者依實際需求調整陶瓷面磚尺寸，將奈米光觸媒材料乾燥至預設狀態後結合釉料，經由一預設溫度進行燒製，使前述結合奈米光觸媒材料及釉料之陶瓷面磚形成所需特質之奈米光觸媒陶瓷面磚，即相當於系爭專利請求項4所揭示之「依據所須以個別取決出合宜形態及寬幅的單元基礎部件，在前述化學藥劑層呈現乾燥至預設狀態，即可在該化學藥劑層作用層面結合至少一層或以上的透光遮覆層、及藉一預設溫度進行燒製，使前述結合化學藥劑層及透光遮覆層的基礎部件構成一所須特質的拋光石英磚；」技術特徵。因此，所屬技術領域中具通常知識者可依證據5、9之揭示而輕易完成系爭專利請求項4之技術內容，證據5、9組合可證明系爭專利請求項4不具進步性。

7. 系爭專利請求項5為請求項4之附屬項，除具有請求項4所述全部技術特徵外，進一步限定附屬技術特徵為「其中該拋光石英磚包括的化學藥劑層在預設層面結合的透光遮覆層，是以釉料層作為其一選擇」。經查，證據5、9之組合可證明系爭專利請求項4不具進步性，業經論述如前，而證據5前言所揭示之「傳統瓷磚多為釉料與無機陶瓷之混合物，」及瓷磚表面上結合釉料乃習知技術，均已相當於系爭專利之透光遮覆層。因此所屬技術領域具通常知識者將奈米光觸媒材料結合釉料，即相當並已揭露系爭專利請求項5之「其中該拋光石英磚包括的化學藥劑層在預設層面結合的透光遮覆層，是以釉料層作為其一選擇」技術特徵。綜上，證據5、9之組合足以證明系爭專利請求項5不具進步性。

㈣證據9、11之組合，足以證明系爭專利請求項1至5不具進步性:

1. 有關證據9之技術內容及系爭專利各請求項之技術特徵，業已說明如前，均不再贅。經查，證據11於第1頁第3.1點揭示「奈米表面處理抗污陶瓷面磚：係指抗污陶瓷面磚表面含有奈米結構者」及第3.4點揭示「陶瓷面磚：主要用於牆面及地面具裝飾及作為保護用之裝修材料，」等語，其中所稱之

牆面及地面、奈米表面處理抗污陶瓷面磚相當於系爭專利之建築物、拋光石英磚；而證據11所稱之面磚，係指應用在建築用的奈米表面處理抗污陶瓷面磚，此部分相當於系爭專利請求項1「是對應用在建築物內、外層面預設區域結合的拋光石英磚是包括：」技術特徵。另證據11第1頁之1.適用範圍進一步揭示「本規範適用於具抗污功能之陶瓷面磚，其抗污功能係源自於奈米表面處理。」及3.用語釋義揭示「3.1奈米表面處理抗污陶瓷面磚：係指抗污陶瓷面磚表面含有奈米結構者」等語，可知證據11之陶瓷面磚、奈米材料相當於系爭專利之基礎部件、化學藥劑層，且該陶瓷面磚表面結合具有抗污功能之奈米材料，前揭技術內容相當於系爭專利請求項1「在預選擇條件的基礎部件表面是允許結合至少一層或以上的具去除懸浮微粒特質的化學藥劑層，及」技術特徵。證據11前言復揭示「奈米表面處理抗污的原理包括…疏水型……，疏水型的原理如同蓮花效應，藉由磁磚表面存在疏水性的奈米結構，使表面可以有自潔功效以防止污垢附著在面磚表面，有助於維持建築物外觀之潔淨」等語，可知證據11所稱之瓷磚表面具有自潔功能，有助於維持建築物外觀之潔淨，相當於系爭專利請求項1揭示之拋光石英磚在整體外層面保持預設定顏色(即排除污垢)及「一併能驅使應用在建築物相應周遭環境存有的懸浮微粒朝地面沉降，藉此消除空氣中難以去除的有害微粒應用」技術特徵。證據9與證據11雖未揭露系爭專利請求項1「在前述的化學藥劑層預設層面是可結合至少一層或以上的透光遮覆層，在藉一預設外在力使前述結合化學藥劑層及透光遮覆層的基礎部件構成一拋光石英磚；」技術特徵，惟在瓷磚表面上結合釉料為習知技術，所屬技術領域具通常知識者將奈米材料上結合釉料，再藉一預設外在力(例如燒製)使結合奈米材料及釉料之陶瓷面磚形成一具抗污能力之奈米表面陶瓷面磚，即已相當於系爭專利請求項1「在前述的化學藥劑層預設層面是可結合至少一層或以上的透光遮覆層，在藉一預設外在力使前述結合化

學藥劑層及透光遮覆層的基礎部件構成一拋光石英磚；」技術特徵。系爭專利並未說明其基礎部件及化學藥劑層之特定組成為何，亦未進一步限定其「化學藥劑層不含奈米材料」，僅界定化學藥劑層具特定功能，是解釋上系爭專利所指之化學藥劑層自包含奈米材料或非奈米材料，而證據11已揭示奈米結構與陶瓷面磚之具體結構，故原告辯稱系爭專利未涉及奈米之技術層次云云，自非可採。證據9及證據11既均為磁磚相關技術領域，兩者之瓷磚表面具有自我潔淨作用之共通功能，所屬技術領域具通常知識者自有動機依證據9、11之教示及習知技術，輕易完成系爭專利請求項1，是證據9、11之組合可證明系爭專利請求項1不具進步性。

2. 系爭專利請求項2為請求項1之附屬項，有關其附屬技術特徵如附表所示，茲不再贅。如前所述，系爭專利請求項2與請求項1之主要差異在於其基礎部件「朝內一側」結合化學藥劑層、化學藥劑層「朝內」結合透光遮覆層，然化學藥劑層設置於基礎部件之「表面」或「朝內一側」及透光遮覆層設置於化學藥劑層的「表面」或「朝內一側」，僅屬位置之改變，所屬技術領域具通常知識者能輕易思及將拋光石英磚之基礎部件、化學藥劑層、透光遮覆層設置位置簡單變更，並無困難，是證據9、11之組合足以證明系爭專利請求項2不具進步性。

3. 系爭專利請求項3為請求項1之附屬項，除請求項1之技術特徵外，更進一步限定如附表所示之技術特徵。如前所述，瓷磚表面上結合釉料為習知技術，此相當於系爭專利之透光遮覆層，是所屬技術領域具通常知識者於奈米光觸媒材料上結合釉料，即相當於系爭專利請求項3所揭示之「其中該拋光石英磚包括的化學藥劑層在預設層面結合的透光遮覆層，是以釉料層作為其一選擇」技術特徵，而證據9與證據11之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性，已如前述，則證據9與證據11之組合自亦足以證明系爭專利請求項3不具進步性。

4. 系爭專利請求項4為獨立項，有關其所揭露之技術特徵如附表所示，而關於證據11所揭示之技術內容，亦如本判決理由㈣1.段所述，均不再贅。如前所述，證據11係揭示應用在建築用之奈米表面處理抗污陶瓷面磚，此相當於系爭專利請求項4揭露之「是對應用在建築物內、外層面預設區域結合的拋光石英磚，在組體實施是採以：」技術特徵。而證據11所揭示之陶瓷面磚表面結合具有抗污功能之奈米材料，此部分亦相當於系爭專利請求項4揭露之「選擇一預設條件的基礎部件，在沿著前述單元基礎部件的作用表面是允許結合至少一層或以上的具去除懸浮微粒特質的化學藥劑層，」技術特徵。另證據11明載其瓷磚表面具有自潔功能，有助於維持建築物外觀之潔淨，此部分相當於系爭專利請求項4之「拋光石英磚在整體外層面保持預設定顏色」技術特徵。而證據11所揭示之藉由磁磚表面存在疏水性的奈米結構，使表面可以有自潔功效以防止污垢附著在面磚表面技術內容，相當於系爭專利請求項4之「有效驅使相應環境所存有的懸浮微粒朝地面沉降，以達到消除建築物預設區域空氣中存在的有害微粒」技術特徵，雖證據9及證據11均未揭露系爭專利請求項4「依據所須以個別取決出合宜形態及寬幅的單元基礎部件，在前述化學藥劑層呈現乾燥至預設狀態，即可在該化學藥劑層作用層面結合至少一層或以上的透光遮覆層、及藉一預設溫度進行燒製，使前述結合化學藥劑層及透光遮覆層的基礎部件構成一所須特質的拋光石英磚；」技術特徵，惟在瓷磚表面使用釉料乃習知技術，此部分相當於系爭專利之透光遮覆層，而依據實際需求狀況調整陶瓷面磚的尺寸，乃實際操作時(貼附牆面或地面)必然採取之手段，並不具無法預期之功效。是所屬技術領域具通常知識者將奈米光觸媒材料乾燥至預設狀態後再結合釉料，並藉一預設溫度進行燒製，以形成一所需特質之奈米光觸媒陶瓷面磚，再依實際需求調整陶瓷面磚的尺寸，此一技術手段相當於系爭專利請求項4所揭示之「依據所須以個別取決出合宜形態及寬幅的單元基礎部

件，在前述化學藥劑層呈現乾燥至預設狀態，即可在該化學藥劑層作用層面結合至少一層或以上的透光遮覆層、及藉一預設溫度進行燒製，使前述結合化學藥劑層及透光遮覆層的基礎部件構成一所須特質的拋光石英磚；」技術特徵，而證據9與證據11既均屬磁磚相關技術領域，所屬技術領域具通常知識者自有可能依證據9、11之教示而輕易完成系爭專利請求項4之技術內容，故證據9、11組合可證明系爭專利請求項4不具進步性。

5. 系爭專利請求項5為請求項4之附屬項，除請求項4所揭示之技術特徵外，其更進一步界定「其中該拋光石英磚包括的化學藥劑層在預設層面結合的透光遮覆層，是以釉料層作為其一選擇」之附屬技術特徵。如前所述，在瓷磚表面上使用釉料乃習知技術，所屬技術領域具通常知識者確有可能在奈米光觸媒材料上結合釉料，此相當於系爭專利請求項5所揭示之「其中該拋光石英磚包括的化學藥劑層在預設層面結合的透光遮覆層，是以釉料層作為其一選擇」技術特徵，而證據9與證據11之組合可以證明系爭專利請求項4不具進步性，已如前述，是證據9與證據11之組合亦足以證明系爭專利請求項5不具進步性。

六、綜上所述，證據5與證據9之組合及證據9與證據11之組合均足以證明系爭專利請求項1至5不具進步性，被告以系爭專利有違核准時專利法第120條準用第22條第2項規定，為舉發成立、撤銷專利權之處分，並無違誤，訴願機關遞為駁回訴願之決定，亦無不合。原告仍執陳詞，求為判決撤銷訴願決定及原處分，即屬無稽，應予駁回。

七、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，及其餘爭點有無理由，已與本件判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　112　　年　　4　　月　　13　　日

智慧財產第二庭

審判長法　官　彭洪英

法　官　曾啓謀

法　官　汪漢卿

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所　需　要　件
(一)符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1.上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
(二)非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所

	屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。
是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明文書影本及委任書。	

中　　華　　民　　國　　112　　年　　4　　月　　24　　日

書記官　邱于婷